



## 75A 75V High Voltage MOS Wafer-BMHDR80S

### 产品描述

BMHDR80S是一款N沟道增强型高压功率MOS场效应晶体管芯片，采用VDMOS平面工艺技术制造而成。先进的工艺以及条状的Cell设计结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量，提高产品的可靠性。

### 极限参数 (T<sub>amb</sub>=25°C)

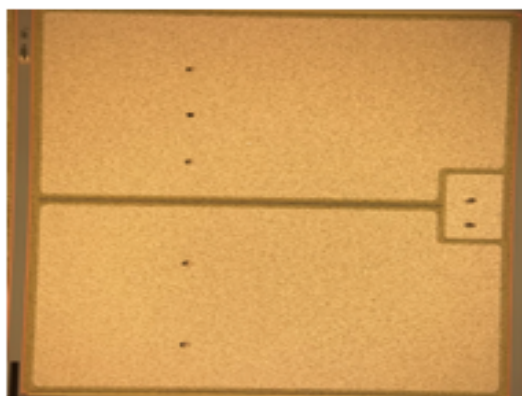
参数名称	符号	额定值	单位
漏源电压	BV <sub>DSS</sub>	75	V
栅源电压	V <sub>GS</sub>	±24	V
漏极电流	I <sub>D</sub>	75	A
工作结温	T <sub>J</sub>	150	°C
存储温度	T <sub>STG</sub>	-55~+150	°C



## 主要典型参数 (Tamb=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV <sub>DSS</sub>	V <sub>GS</sub> =0V, I <sub>D</sub> =250uA	75	-	-	V
栅源击穿电压	V <sub>TH</sub>	V <sub>GS</sub> =V <sub>DS</sub> , I <sub>D</sub> =250uA	2.5	-	3.8	V
栅源极漏电流	I <sub>GSS</sub>	V <sub>GS</sub> =±24V, V <sub>DS</sub> =0V	-	-	90	nA
漏源极漏电流	I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> =70V, V <sub>GS</sub> =0V	-	-	300	uA
导通电阻	R <sub>DSON</sub>	V <sub>GS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =2A	-	-	20	mΩ
漏源极寄生 本体二极管 正向导通压降	V <sub>FSD</sub>	I <sub>S</sub> =1A, V <sub>GS</sub> =0V		-	1.3	V

## 芯片内部示意图





芯片基本参数		
参数名称	参数描述	单位
晶元尺寸	6'	Inch
管芯尺寸	2700 * 2970	um*um
管芯数量	1868	Dies/Wafer
晶元厚度	150±15um	um
正面金属/厚度	AlSi	um
背面金属/厚度	Ti/Ni/Ag	um
栅极焊点尺寸	/	um*um
源极焊点尺寸	/	um*um
切割道宽度	70*70	um*um



## 声明:

·明月微电子保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息是否完整和最新。

·任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能,买方有责任在使用 **BMS** 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!

·产品提升永无止境,我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

## MOS Wafer操作注意事项:

静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电影响而引起的损坏:

- 操作人员要通过防静电腕带接地。
- 设备外壳必须接地。
- 装配过程中使用的工具必须接地。
- 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



产品名称: BMHDR80S

文档类型: 芯片说明书

版权: 深圳市明月微电子有限公司

公司主页: <http://www.bmsemi.com>

版本号: 2016ver1.0.8

修订审核: 2018/11/1